2SJ458

PチャネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ
超高速スイッチング用

暫定規格

特長　高速ダイオード内蔵

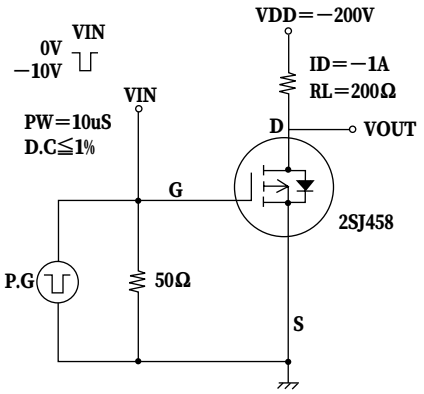
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings／Ta=25℃

			unit
ドレイン・ソース耐圧	VDSS	−450	V
ゲート・ソース耐圧	VGSS	±30	V
ドレイン電流（DC）	ID	−2	A
ドレイン電流（パルス）	IDp	−8	A
許容損失	PD　(Tc=25℃)	60	W
チャネル温度	Tch	150	℃
保存周囲温度	Tstg	−55〜+150	℃

電気的特性 Electrical Characteristics／Ta=25℃

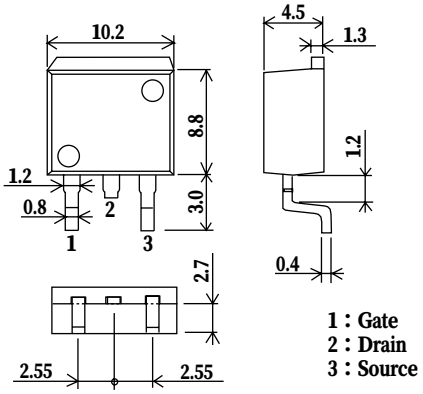
			min	typ	max	unit
ドレイン・ソース降伏電圧	V(BR)DSS	ID=−10mA , VGS=0	−450			V
ドレイン・ソースしゃ断電流	IDSS	VDS=−360V, VGS=0			−1.0	mA
ゲート・ソースもれ電流	IGSS	VGS=±30V , VDS=0			±100	nA
カットオフ電圧	VGS(off)	VDS= −10V , ID=−1mA	−2.0		−3.0	V
順伝達アドミタンス	|yfs|	VDS= −10V , ID=−1A	0.6	1.2		S
飽和抵抗	RDS(on)	ID=−1A , VGS=−10V		4.0	5.5	Ω
入力容量	Ciss	VDS=−20V , f=1MHz		700		pF
出力容量	Coss	VDS=−20V , f=1MHz		110		pF
帰還容量	Crss	VDS=−20V , f=1MHz		40		pF
ターンオン遅延時間	td(on)	下図指定測定回路において		25		ns
立ち上がり時間	tr	〃		28		ns
ターンオフ遅延時間	td(off)	〃		160		ns
下降時間	tf	〃		55		ns
ダイオード順電圧	VSD	IS=−2A , VGS=0			−1.5	V
ダイオード逆回復時間	trr	IS=−2A , di / dt=100A/μs		120	155	ns

スイッチングタイム測定回路



外形図

SMP−FD(unit：mm)



※これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

〒370-05 群馬県大泉町坂田一丁目1番1号　三洋電機株式会社 半導体事業本部